

198НТ1А, Микросхема интегральная

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#)

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#)

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#)

198НТ1А микросхемы полупроводниковой:

198НТ1А — цифровая микросхема являются транзисторной логикой с функционалом матрицы транзисторов NPN типаи используются в РЭА в большой области эксплуатации. Производятся в керамометаллическом корпусе 401.14-5. Модель изделия наносится на металлической части корпуса. Номинальное значение нагрева при эксплуатации от минус 60 до плюс 125град С. Климатически исполнены УХЛ и соответствует 2) техусловиям ШПО.348,002ТУ.

Ссылки на технические материалы

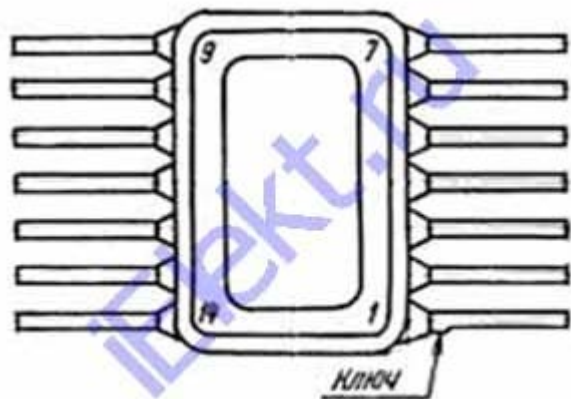
ссылки на 198НТ1А дополнительный материал:

карта	фото ТИП1, ТИП2	схема выводов ТИП1, ТИП2
значение выводов	параметры	предельные параметры
эксплуатация	PDF	

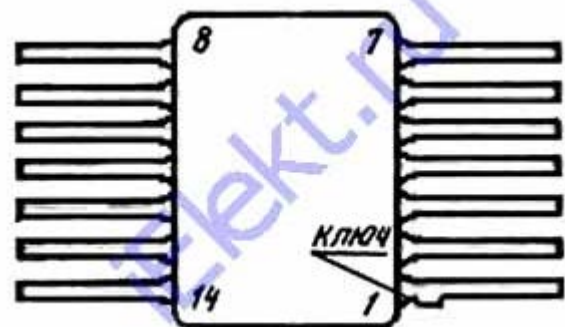
Знак завода изготовителя



Расположения выводов схематическое

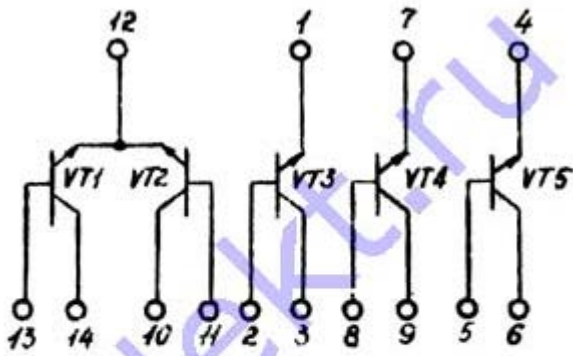


ТИП1 вес не превышает 0,5g.



ТИП2 вес не превышает 0,6g.

Схема электрическая принципиальная для НТ1



Для 198НТ2 - без транзистора VT4

Для 198НТ3 - без транзистора VT1

Для НТ2 - без транзистора VT4

Для НТ3 - без транзистора VT1

Основные электрические параметры при $t=25\pm 10$ градусов Цельсия

таблица основных 198НТ1А электро показателей:

Название характеристики, единица и режим замера	Буквенное обозначение	Допуск							
		НТ1А, НТ2А		НТ1Б, НТ2Б		НТ1В		НТ3	
		больше	меньше	больше	меньше	больше	меньше	больше	меньше
Статический коэффициент передачи тока транзистора (при $U_{кб}=3V$; $I_{э}=0,5mA$; для НТ1В $I_{э}=0,05mA$)	$h_{21э}$	30	200	30	200	50	150	30	200
Обратный ток коллектора, μA (при $U_{кб}=6V$)	ИКБО	-	0,05	-	0,05	-	0,05	-	0,05
Напряжение насыщения база-эмиттер, V (при $I_{к}=3mA$, $I_{б}=0,5mA$)	U БЭнас	-	0,8	-	0,8	-	0,8	-	0,8
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, V (при $I_{к}=3mA$, $I_{б}=0,5mA$)	U КЭнас	-	0,2	-	0,2	-	0,2	-	0,2
Разброс статических коэффициентов передачи тока транзисторов дифференциальной пары, % (при $U_{кб}=3V$; $I_{э}=0,5mA$; для НТ1В $I_{э}=0,05mA$)	Sh21Э	-	15	-	15	-	15	-	15
Разброс напряжения между базой и эмиттером транзисторов дифференциальной пары, mV (при $\sum I_{э}=0,5mA$, $U_{кб}=3V$)	бУБЭ	-	3	-	10	-	3	-	-

Предельные 198НТ1А параметры

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.